Quick Vertical Test System for L-band Superconducting RF Cavities

Kenji SAITO, Takeo FUJINO, Tamao HIGUCHI*, Shuichi NOGUCHI, Masaaki ONO, Eiji KAKO and Toshio SHISHIDO

KEK : National Laboratory for High Energy Physics
1-1, Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, 305, Japan
* Nomura Plating Co. Ltd. : 5, Satsuki-cho, Kanuma-shi, Tochigi-ken, 322, Japan

Abstract

[P30 - 29]

Generally saying, the experimental inertia of the superconducting RF cavities is very large due to cryogenics. In order to increase frequency of the cold test and promote the activity, we need a quick vertical test system. We built such a system for L-band cavities so that we could make experiment three times in a week. In this paper, we describe the system and report some results from this system.

L-バンド超伝導空洞用簡易縦測定システム

1. はじめに

超伝導空洞の低温測定は多くの準備作業があり、一般 に実験慣性が大きい。KEKの伝統的測定方法では以下の 手順が必要である。1)空洞の表面処理、2)空洞のク リーン・ルーム内組立、3) 真空排気、4) 縦測定用空 洞吊り下げスタンドへの取付け、5)縦測定スタンドの 真空排気系と空洞の真空接続、6)吊り下げスタンドの クライオスタットへのマウント、7)液体窒素予冷、8) 液体ヘリウムのトランスファー、9)空洞測定(4.2K: He-I)、10) Lーバンドの場合は、減圧クーリングして 測定(2-1.7K:He-II)。これらの全工程を通して、測定 結果が得られまでに一週間かかる。我々は、Lーバンド 超伝導空洞のアクティビティを上げるために、上記のよ うな作業工程の内4)-7)を省くことにより、最短で 二日モードの測定が可能な新システムを作った。このシ ステムと旧システムを併用することにより、週三回の測 定が出来るようになり、空洞性能に関して統計性に基づ く議論が可能になった。また、新システムでは、1.3Kま で冷却できるため1 x 10¹¹台の非常に高いQo値 (unloaded Q value)が得られ、高感度で空洞性能を評価 できるようになった。本論文では、新システムの構造、

特徴、得られた空洞測定結果等を報告する。

2. 新システムの設計思想

1) 空洞封じ切り測定

上記の作業工程では、空洞の吊り下げから予冷の間で 全作業時間の半分を費している。超伝導空洞は、低温に 冷却されるとそれ自体クライオポンプとなり、空洞内表 面に真空システム内の残留ガスを吸着する。このガス吸 着のことを考えれば、空洞を真空排気した後、封じ切り で測定する方が良いかも知れない。そうすれば、上記の 4)、5)の作業が省け、作業が大幅に簡略化される。 2)液体窒素予冷の省略とfast cooldown



図1、クライオスタットと空洞吊り下げスタンド.

-222-

クーリングに際して、日本ではヘリウムの値段が高い のでその負荷を極力減らすために、KEKでは伝統的に液 体窒素予冷を行っている。この工程は夜間行われるため に作業時間はさほど問題にならないが、測定作業全体の スケジュールに大きな影響を及ぼす。ヘリウム槽やその 中に入る空洞吊り下げスタンドの熱容量を極力小さくし て、それらの熱負荷が液体ヘリウム冷却でも問題になら ないようにして、この工程を省くことが望ましい。また、 クライオスタットの熱容量を小さくすればfast cooldown が可能になり、Qo-disease (水素病)の問題[1]にも対処 できる。

3) 小熱侵入化と9 セル空洞対応

クライオスタット内への熱侵入量を小さくすることは、 液体ヘリウムの消費量を減し、長時間実験を可能にする 点で重要である。しかし、この問題はHe-II(超流動ヘリ ウム)下での空洞性能測定で特に重要である。He-II温度 で能測定する際、液体ヘリウムを減圧してヘリウム温度 を下げる。この時、液体ヘリウムの量は熱侵入を考慮に 入れなくても、4.2KのHe-Iの半分程になる。性能測定中、 空洞が液体ヘリウムから顔を出さないように液面高さを 十分確保しなければならない。熱侵入が多いと減圧時に 著しく液面が低下し、9セル空洞のように1.3mもある空 洞への対処が難しい。新システムでは、9セル空洞でも 十分高い液面を確保できるように、熱侵入を小さくし、 さらに、ヘリウム槽の断面積を小さく、深くした。

3. システムの構造と性能

Blue Cryostat の構造:上記の設計思想の下に、我々 はヘリウム槽の内径を300Φ、深さを3mとした。これら の仕様を満たすクライオスタットを東理社を介してアメ リカのPrecision Cryogenic Systems Inc. から購入した。 図1にその構造を示す。クライオスタット外径483mm、 全長3226mm、クライオ槽内径301mm、深さ3048mmで ある。ヘリウム槽は熱侵入を小さくするために上から 508mmまではFRPでできており、そこから下は軽量化の ためアルミ製である。真空断熱槽の中にはスーパーイン シュレーションと活性炭ゲッターが取り付けられている のみで、液体窒素シールドの無い簡単な構造になってい る。また、真空断熱槽はバルブ封じであり、必要に応じ て真空排気するようになっている。液体窒素シールドが 無いので取扱が非常に容易であることは、強調されるべ きであろう。このクライオスタットの外観が青色なので Blue Cryo.と呼んでいる。

縦吊り下げスタンド:1図に示す空洞吊り下げスタン ドを製作した。空洞は上部のフランジを顎にして吊り下 げられる。ゴミが空洞内部に落下するのを避けるために、 RFのインプト・カップラーを空洞の下部側に取付けた。 クライオスタットの天盤外側に取り付けたパルス・モー タで、シャフト、門型枠を介してカップラーのアンテを 上下駆動する構造となっている。 インプット・カップラー:インプット・カップラーは 同軸タイプである。コネクター付ベロー中にアンテナを 取付け、液体ヘリウム中でもアンテナを空洞に出し入れ できるようにしている。ベローは、フランジに立てた4 本の棒をガイドにテフロン・ブッシュを介してパルス・ モーターで上下駆動される。Lーバンド空洞では、He-Iか らHe-IIの測定で空洞のQoは10⁸台から10¹¹まで変わり、 それに合わせてアンテナを出し入れする必要があり、最 低20mmのストロークが必要である。しかし、アンテナ の長さを実験的に決める必要があるので40mm程度のス トロークがあった方が良い。

磁気シールド:浮遊磁場の存在下で空洞を冷却して超 伝導状態にすると磁場がニオブにトラップされ、表面抵 抗が発生する。浮遊磁場をシールドするためには、磁気 シールドを付けるのが常套手段となっている。このシス テムでは、ヘリウム槽内に東北金属(株)のスパー・パー マロイ製の肉厚1mm、内径295Φ、長さ2mの一層の円筒 形(底付き)磁気シールドを挿入している。図2にこの シールドを入れた時のヘリウム槽内の常温での磁場分布 を示す。測定には、F.W.BELL社製の Model 9200 ホール 素子磁場測定器(測定感度0.1mGauss)を使用した。垂 直成分は、シールドすぐ内側で90°置きに4箇所とシー ルドの中心軸上の計5箇所で測定した。一方、浮遊磁場 の主成分が地磁気であり、水平成分はセンサーの向きに よって強さが変わるので、中心軸上でセンサーを水平面 内で回転させピークホールドによる最大値を取った。シー ルドの上部が開口のため垂直成分がシールドの直径程度 侵入し、底から1.6m程しか有効でないことが分かる。有 効範囲では、垂直残留磁場は 6 mGauss、水平残留磁場は 4.5 mGaussである。

Cooldown speed: 実際にクライオスタット内にL-バ ンド単セル空洞を吊り下げた状態でシステムを冷却試験 した。Qo-diseaseに影響しない温度領域(液体窒素温度 77K以下)まで冷却するのに、65Qの液体へリウムを消 費して25分、さらに、そこからへリウムが溜まり始める までに39Qの液を消費し、35分要した。液が溜まり始め



るまでトータルで104 Qの液体ヘリウムを消費し、55分 要した。また、液面2mまで溜めるのに136 Qの液体ヘリ ウムが必要であった。したがって、一回の実験で240 Q の液体ヘリムが必要である。しかし、最近ではヘリウム による冷却を注意深くやることで、ヘリウムの全消費量 を200 Qまで減らせた。

熱侵入量:液体ヘリウムをヘリウム槽の底から2m程溜 めた後、4.2Kで一晩放置して液面下降率から熱侵入量を 測定した。液面1815mmで1.14W、1587mmで1.01Wと液 面が下がるにしたがって熱侵入量が減少する傾向がある が、全体として1.1Wである。

到達温度:超伝導空洞の表面抵抗はよく知られているように、冷却温度に対して指数関数的に減少するBCS表面 抵抗と温度に依らない残留表面抵抗の和で表わされる。 残留表面抵抗が非常に小さい場合には、空洞の冷却温度 を1.5K以下まで下げないと正確な値が求まらない。この システムで液体ヘリウムを減圧してどこまで冷やせるか 試験した結果、1時間半のポンピングで1.22Torr すなわ ち、1.24K まで冷やせることが分かった。

4. 新システムで測定した空洞性能

表面抵抗:新システムを使って測定した空洞の表面抵抗の温度依存性(T=4.2-1.4K)を図3に示す。このデータをフィットして求めたニオブの超伝導換算ギャップ・エネルギーは、 $\Delta/k_B = 18.4$ (ここで、 k_B はボルツマン定数)であり、これまでのデータと矛盾しない。残留表面抵抗の大きさは、 $3.2n\Omega$ である。残留表面抵抗がこれ程小さくなると、図3のようにデータ・フィッティングで求めるには、十分低い温度まで測定しなければならない。幸い、このシステムでは熱侵入が小さいので低い温度まで下げられ、誤差の少ないデータを提供できることがわかる。

文献 [2] によれば、残留磁場の空洞のビームパイプ 軸に平行な成分と垂直成分の表面抵抗への寄与は、0.25 n Ω /mGauss (parallel)、0.22 n Ω /mGauss (perpendicular) である。スーパー・パーマロイのシールド特性が極低温 で変わらないとしてこれらの値を使うと、残留磁場が原





因となる残留表面抵抗は、Rres(parallel) = $1.5 n\Omega$ 、Rres (perpendicular) = $0.99 n\Omega$ 、トタールでRres = $2.5 n\Omega$ と見 積もられ、測定結果を説明する。残留表面抵抗の主原因 は残留磁場によるもので、空洞表面自体に起因するもの は極わずか ($1n\Omega$ 程度) であることが示唆される。

Qo-Eacc カーブ:このシステムで測定された加速電界 (Eacc)とQo値の関係を図4に示す。残留表面抵抗が小さ く、且つ、低い温度(1.3-1.5K)で測定しているので Qo=10¹¹の非常に高いQ値が得られている。マルチパクタ リングが起き、プロセッシングする必要があったので、 同じ試験で三回測定されている(Qolst-Qo3rd)。加速 電界は、熱的クエンチ (self pulsing) により31MV/mに 制限された。また、4.2Kでも測定されが、RFパワー不 足により、17MV/mまでしか測れなかった。マルチパク タリングは、このシステムに限らず、別のシステムでも 観測されている。このシステムでは真空封じで空洞を測 定する方法を採用したので、高電界の測定にその影響が 出ないか不安ではあったが、30MV/m以上の高電界の測 定ができた。また、同じ空洞に高圧水洗のみを施し、新 旧両システムで測定して性能を比較した結果、同様な結 果が得られた。したがって、現状では、新システムに測 定上の問題は無いと考えている。

5. まとめ

新システムでは、真空封じで空洞を測定することで、 実験準備作業を大幅に簡略化でき、表面処理を含め最短 二日で測定結果を出すことができる。クライオスタット の熱侵入が小さく1.3Kまでの低い温度まで冷却でき、ま た、ヘリウム槽内の残留磁場が小さいために非常に高い Q値が得られる。30MV/m以上の加速電界も問題なく測定 できることがわかった。

参考文献

[1] K.SAITO et. al., "Qo-Degradation due to Hydrogen in High Pure Niobium Cavities ", Proc. of the 18th Linear Accelerator Meeting in Japan, Tsukuba, 21-23, July, 1993. P.299.



[2] P.Kneise and B.Lewis, CEBAF TechNote #94-028.